# a-Si:H/SiNx導波層を有する磁気光学導波路の試作

Fabrication of magneto-optic waveguides with a-Si:H/SiNx layers

芝浦工大院理工<sup>1</sup>、芝浦工大 グリーンイノベーション研究センター<sup>2</sup>

高際健児<sup>1</sup>、Salinee Choowitsakunlert<sup>1</sup>、細谷斉昭<sup>1</sup>、横井秀樹<sup>1,2</sup>

Shibaura Inst. of Technol<sup>1</sup>, SIT Research Center for Green Innovation<sup>2</sup> °Kenji Takagiwa<sup>1</sup>,

Salinee Choowitsakunlert<sup>1</sup>, Nariaki Hosoya<sup>1</sup>, Hideki Yokoi<sup>1,2</sup>

E-mail: ma16064@shibaura-it.ac.jp

### 1. まえがき

光通信において、非相反な特性を有する光アイソレ ータは、半導体レーザの発振安定化のために必要不可 欠な素子である。近赤外領域では、光吸収損失が小さ く、且つ大きな磁気光学効果を有する磁性ガーネット を用いて光アイソレータは構成される。非相反移相効 果を利用した光アイソレータは一偏波のみで動作する ため位相整合が不要であり、磁化の制御も容易である [1,2]。

筆者らは、a-Si:H 導波層を有する光アイソレータの 実現に向けて研究を行っている。a-Si:H の成膜には多 くの方法が提案されているが、PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)法による成膜は比 較的低温での成膜が可能である[3]。a-Si:Hを成膜する 際に磁性ガーネット上にバッファ層を堆積する場合、 光波の伝搬に影響がでる可能性がある。本研究では、 a-Si:H の成膜時にバッファ層として SiNx を採用した 場合の導波路内の光波の伝搬について調べたので報告 する。

### 2. 素子構造及び解析

図1に、直線リブ型導波路からなる非相反導波モー ドー放射モード変換型光アイソレータを示す。磁気光 学導波路は(Ca,Mg,Zr)-doped Gd<sub>3</sub>GasO<sub>12</sub> (GCGMZG)基 板上に成膜された(CeY)<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (Ce:YIG)クラッド層を 有する。Ce:YIG クラッド層の上に、バッファ層(SiNx) を介して a-Si:H 導波層が成膜され、磁気光学導波路を 構成する。印加された外部磁界における光波の進行方 向に垂直な成分により、導波路を伝搬する TM モード には非相反移相効果を生じる。リブ型導波路の幅と高 さを調節することにより、伝搬定数には、以下の関係 式が成り立つ。

## $\beta_b^{\mathcal{Y}} < \beta_c^{\mathcal{X}} < \beta_f^{\mathcal{Y}}$

ここで、 $\beta_b^{y} \geq \beta_f^{y}$ はそれぞれ順方向及び逆方向に伝搬 する TM 基本モードの伝搬定数、 $\beta_c^{x}$ は TE モードのカ ットオフを表す。逆方向に伝搬する TM モードのみ TE 放射モードに結合するため、TM モード動作光アイソ レータとして機能する。

図1に示す素子を波長1.55µmにおいて設計するため に、SiO<sub>2</sub>/a-Si:H/SiNx/Ce:YIG/GCGMZG構造の磁気光学 導波路の非相反移相量の大きさを計算した。バッファ 層としてSiNx(波長1.55µmにおいてn=1.972)を用いた 場合、a-Si:H導波層厚さが0.2µmの時、Ce:YIGクラッ ド層厚さが0.5µmより大きい時、非相反移相量は最大 となる。a-Si:H導波層厚さを0.2µm、Ce:YIGクラッド 層厚さを0.5µmとして、リブ型導波層の幅と高さを調 整して、伝搬定数が式(1)の関係式を満足する条件を調 べた。その結果、バッファ層を挟んだ場合でもリブ型 導波路のパラメータを精密に制御できれば、光アイソ レータとして機能することが分かった。

### 3. 製作及び測定方法

スパッタリングにより GCGMZG 基板上に Ce:YIG を堆積させ、その上に PECVD 法によりバッファ層 SiNx、導波層 a-Si:H を堆積させた。導波路構造を製作 後にオーバークラッドとして PECVD 法により SiO2を 堆積させ、図1の導波路構造を製作した。

試作した磁気光学導波路に波長 1.55μm のレーザ光 を入射させて近視野像を観察した。図2に示す近視野 像より、光波は a-Si:H 導波層に閉じ込められて伝搬し ていることが分かる。



(Gd,Ca)3(Ga,Mg,Zr)5O12

図1 a-Si:H/SiNx 導波層を有する磁気光学導波路



図2 磁気光学導波路からの出射光の近視野像

#### 謝辞

(1)

本研究の一部は、文科学省「ナノテクノロジープラ ットフォーム」事業「微細加工ナノプラットフォーム コンソーシアム」の支援による成果であることを記し、 感謝します。また、本研究の一部は、芝浦工業大学グ リーンイノベーション研究センターの助成により行わ れた。

参考文献

- T. Mizumoto, S. Mashimo, T. Ida, and Y. Naito: IEEE Trans. Magn., vol. 29, no. 6, pp. 3417-3419, 1993.
- [2] H. Yokoi, T. Mizumoto, T. Takano, and N. Shinjo: Appl. Opt., vol. 38, no. 36, pp. 7409-7413, 1999.
- [3] J. Kang, Y. Atsumi, M. Oda, T.Amemiya, N. Nishiyama and S. Arai: Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 50, no. 12, 120208-1-120208-3, 2010.